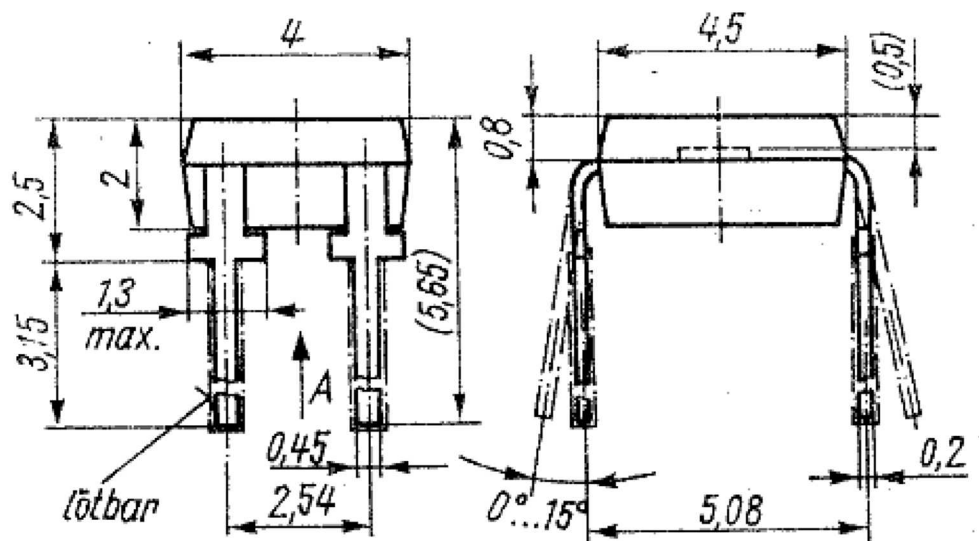


## Kreis-Kreisringfotodiode

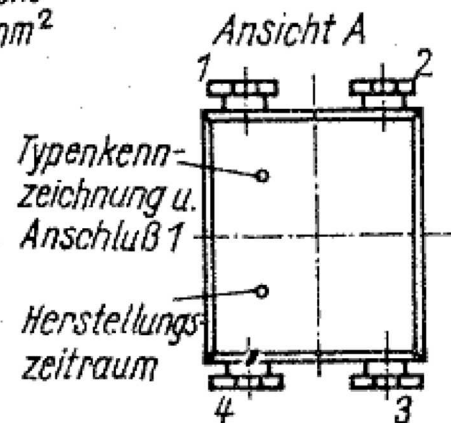
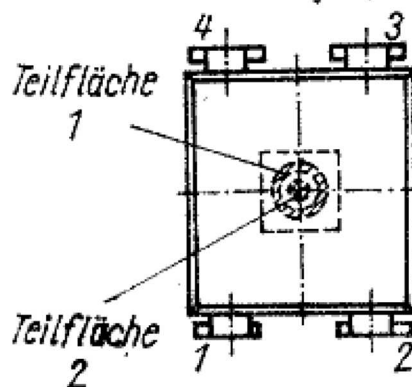
Sie eignet sich für Dioden- und Elementebetrieb, weist ein niedriges Dunkelstromniveau auf und ist durch ein geringes Übersprechen gekennzeichnet.

Einsatzgebiete sind die Meß-, Steuer- und Regelungstechnik, insbesondere Nachlaufsteuerungen, Kantenführungen sowie Weg- und Winkelabtastungen.

Transparentes Kunststoffgehäuse



strahlungsempfindliche  
Teilfläche je  $0,283 \text{ mm}^2$



### Anschlußbelegung

- 1 nicht belegt
- 2 Katode
- 3 Teilfläche 1
- 4 Teilfläche 2

### Grenzwerte

		min	typ	max
Sperrgleichspannung <sup>1)</sup>	$U_R$			30 V
Verlustleistung je Teilfläche	$P_{Trn}$			75 mW
Betriebstemperatur	$\vartheta_a$	-15		+55 °C
Lagertemperatur	$\vartheta_{stg}$	-25		+70 °C

**Kenngrößen bei  $\vartheta_a = 25\text{ °C}$**

Dunkelsperrstrom <sup>1)</sup> $E_e = 0\text{ lx}, U_R = 20\text{ V}$	$I_{RO}$	0,1	5	nA
Spektrale Empfindlichkeit $\lambda = 633\text{ nm}, U_R = 20\text{ V},$ $\Delta\lambda_{0,5} \leq 10\text{ nm}$	$S_\lambda$	0,25	0,33	A/W
Integrale Empfindlichkeit <sup>1)</sup> $U_R = 10\text{ V}, E_v = 1\text{ klx}^2)$	$s_{tot}$	1,0		$\mu\text{A/klx}$
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit $\Delta\lambda_{0,5} \leq 10\text{ nm}, U_R = 20\text{ V},$ $R_L < 100\text{ Ohm}$	$\lambda_S$	600	700	800 nm
Impulsanstiegszeit <sup>1)</sup>	$t_r$	40	100	ns
Impulsabfallzeit <sup>1)</sup>	$t_f$	40	100	ns
$U_R = 20\text{ V}$ $R_L = 50\text{ Ohm}$ $\lambda = 850\text{ nm}$				
Laterale Inhomogenität der Fotoempfindlichkeit $U_R = 20\text{ V}$	$\frac{\Delta S(L)}{\Delta S(O)} \cdot 100$	3	5	%
Normlichtart A Lichtfleckdurchmesser 50 $\mu\text{m}$				
Übersprechen	$\frac{I_{p2}}{I_{p1}} \cdot 100$	2	5	%

<sup>1)</sup> bezogen auf ein Element

<sup>2)</sup> gemessen mit Normlichtart A nach TGL 37 363 in Richtung der geometrischen Achse